

n channel field effect transistors — plastic case

transistors à effet de champ canal n — boîtier plastique

Type	Application	$V_{(BR)GSS}$		I_{GSS}	I_{DSS}		Y_{21s}		V_{GSoff}		C_{11ss} typ* max (pF)	C_{12ss} typ* max (pF)	r_{DSon} max (Ω)	F / f		Case
		min (V)	max (nA)		min	max (mA)	min	max (mS)	min	max (V)				max (MHz)*	(dB) (KHz)	
2N 3819	AR/RF general purpose <i>Usage général</i> BH/HF	-25	2	2	20	2	6,5	-	8	8	4					
BC 264 BF 245 BF 247	AR/RF general purpose <i>Usage général</i> BH/HF	-30 -30 -25	10 5 5	2 (1) 2 (1) 10 (1)	12 25 300	2,5 3 8	6,5	-0,5 - 8 -0,5 - 8 -0,6 - 14,5	4 * 4 * 15 *	1,2* 1,1* 3,5*				2	1000	
2N 5245 2N 5246 2N 5247 BF 256	UHF/VHF amplification	-30 -30 -30 -30	1 1 1 5	5 1,5 8 3	15 7 24	4,5 3 4,5	7,5 6 8	-1 - 6 -0,5 - 4 -1,5 - 8 -0,5 - 7,5	4,5 4,5 4,5 4,5	1 1 1 1,2			4	400*		
ESM 4091 ESM 4092 ESM 4093	Switching <i>Commutation</i>	-30 -30 -30	1 1 1	30 15 8				-5 - 10 -2 - 7 -1 - 5	28 28 28	5 5 5			30 50 80			
ESM 4302 ESM 4303 ESM 4304	AR/RF general purpose <i>Usage général</i> BF/HF	-30 -30 -30	1 1 1	0,5 4 0,5	5 10 15	1 2 1		-4 -6 -10	6 6 6	3 3 3			2 2 3	1000 1000 1000		

(1) : Available in several I_{DSS} groups
Disponible en plusieurs groupes de I_{DSS}

fet dual transistors, n channel

transistors double à effet de champ-canal n

Type	Application	$V_{(BR)GSS}$		I_{GSS} max	I_{DSS}	Y_{21s}	V_{GSoff}	C_{11ss}	C_{12ss}	Matching <i>Appariement</i>				Case
		min (V)	max (nA)							min-max (mA)	min-max (mS)	min-max (V)	max (pF)	
ESM 25 ESM 25 A 2N 5198 2N 5199	AR/RF general purpose <i>Usage général</i> BF/HF	-30 -30 -30 -30	0,1 0,1 25 * 25 *	0,5-10 0,5-10	1-5 1-5	1-5 1-5	-0,7-4,5 -0,7-4,5	6 6	2 2	20 20	20 20	25 25	80 50	
								6 6	2 2	5 5	5 5	10 10	20 40	